

## Medium Power Transistor

### 最大额定值

参数	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压 ( $I_B=0$ )	$V_{CE0}$	32	V
集电极-基极电压 ( $I_E=0$ )	$V_{CB0}$	40	V
发射极-基极电压 ( $I_C=0$ )	$V_{EB0}$	6	V
集电极电流	$I_C$	1	A
总耗散功率 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )*	$P_{tot}$	1	W
最高结温	$T_{jm}$	150	$^\circ\text{C}$
贮存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



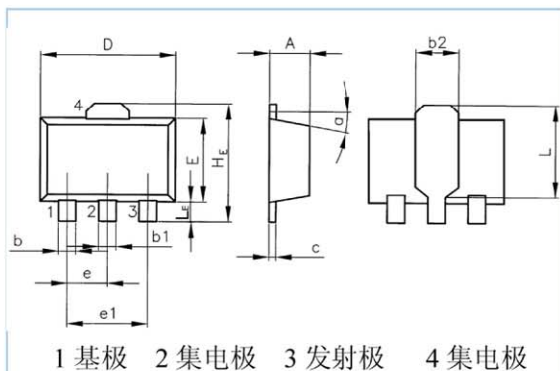
\* 器件安装在陶瓷基板上

### 电特性 (除非另有规定, $T_A=25^\circ\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
击穿电压	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	32	—	—	V
	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=50\mu\text{A}, I_E=0$	40	—	—	V
	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=50\mu\text{A}, I_C=0$	6	—	—	V
集电极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	500	nA
直流放大系数	$h_{FE}$	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=3.0\text{V}$	120	—	270	—
			180	—	390	—
集电极-发射极饱和电压 <sup>1)</sup>	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	0.50	V
特征频率	$f_T$	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	150	—	—	MHz

1) 脉冲法: 脉宽 300 $\mu\text{s}$ , 占空比 $\leq 2\%$

### SOT-89 外形尺寸



单位: mm

尺寸 符号	SOT-89			尺寸 符号	SOT-89		
	min	typ	max		min	typ	max
A		1.5		e		1.5	
b			0.65	e1		3	
b1			0.65	$H_{FE}$			4.25
b2		1.6		L	2.6		2.95
c	0.25			$L_{FE}$	0.8		1.2
D		4.5		a			$10^\circ$
E			2.6				

$h_{FE}$  values are classified as follows

Item	Q	R
$h_{FE}$	120 to 270	180 to 390



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>SHIKUES\(时科\)](#)